

## 一、概述

SC8002B 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时，负载（4Ω）上的最大输出功率为 2.5W。而对于手提设备而言，当 VDD 作用于关断端时，SC8002B 将会进入关断模式，此时的功耗极低，IQ 仅为 0.6uA。

SC8002B 是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.0V~5.0V 的输入电压下即可工作。

## 二、功能特点

- 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
- 稳定的增益输出。
- 外部增益设置。
- 封装形式: SOP-8

## 三、应用

- 可应用于手提设备，台式电脑及低电压工作的音频设备。

## 四、管脚排列及说明

管脚排列图	序号	名称	类型	说明
	1	SHUTDOWN	I	关断端口
	2	BYPASS	I	电压基准端
	3	+IN	I	正向输入端
	4	-IN	I	反向输入端
	5	VO1	O	音量输出端 1
	6	VDD	POWER	电源端
	7	GND	POWER	接地端
	8	VO2	O	音量输出端 2

注: I: 输入; O: 输出; POWER: 电源。

SC8002B(文件编号: S&CIC0869)

## 五、功能说明

### ➤ 桥路设置

SC8002B 内部共有 2 个运放工作，但 2 个运放的设置却有所不同。

第一个运放增益可在外部用 RF 和 RJ 两个电阻进行设置（+IN 和 -IN 端口），而第二个运放的增益则固定不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号，而且两个运放产生的信号数量相同，相位相反。因此 SC8002B 增益如下： $A_{VD} = 2 \times (R_f/R_i)$

为驱动负载，运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地，在同等条件下能使负载产生 4 倍的输出功率。

### ➤ 功耗

使用桥接的运放电路，负载上产生的功耗也比较大，因此在规定电压的条件下，负载功耗如下：

$$P_{DMAX} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2\pi^2) R_L$$

因此在 5V 输入，8Ω 负载情况下，输出最大功耗为 625mW。但是此算法得出的结果如下：

$$P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$$

注：SOP 封装  $\theta_{JA} = 140^\circ C/W$

### ➤ 基准电压

电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 SC8002B，1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。

### ➤ 关断功能

为了减少功耗，SC8002B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时，运放关闭，SC8002B 不工作，这时 SC8002B 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略低于 VDD 时，SC8002B 工作状态不稳定。所以，关断端应置于一个稳定的电压值，以免 IC 进入错误的工作状态。

在很多应用场合，关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时，可以在关断端加上拉电阻，这样当开关关断时，因上拉电阻的作用，使得 SC8002B 关断端的电平处于一个正确的状态，以保证 SC8002B 不会进入错误的工作状态。

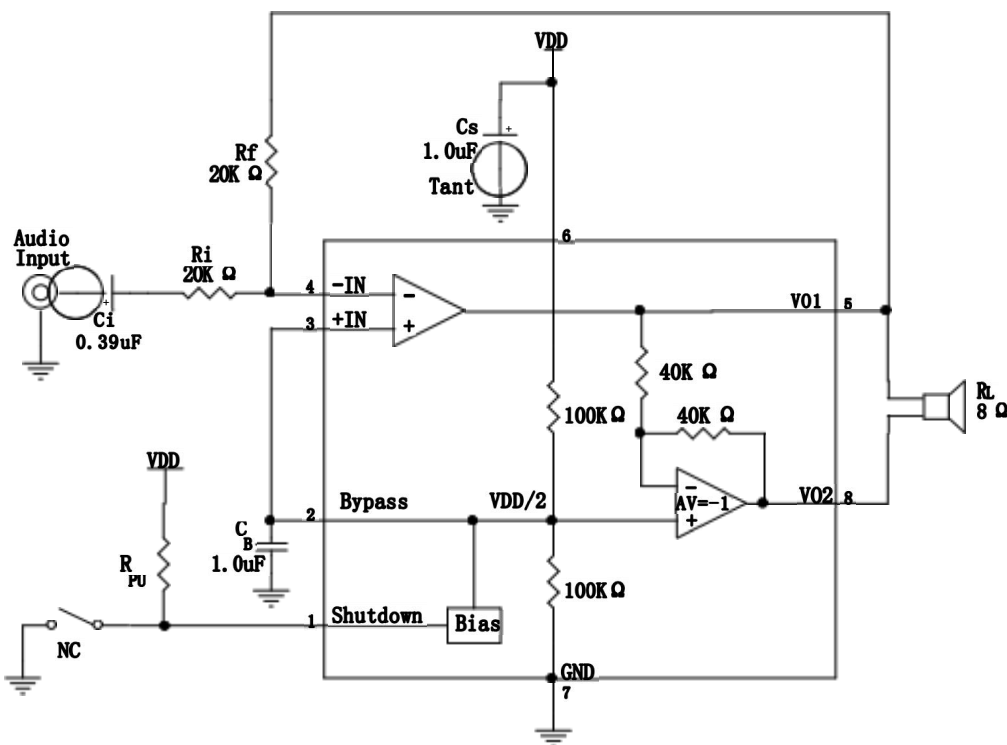
## 六、极限参数(Ta=25℃)

特性	符号	范围	单位
工作电压	V <sub>DD</sub>	5.5	V
输入电压	V <sub>IN</sub>	-0.3~V <sub>DD</sub> +0.3	V
工作温度	T <sub>OPR</sub>	-65~+150	℃
环境温度	T <sub>A</sub>	-40~+85	℃
节点温度	T <sub>J</sub>	150	℃

七、电气参数 (VDD=5V, RL=8Ω, Ta=25°C)

名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
工作电压	V <sub>DD</sub>	2.0	--	5.0	V	
静态电流	I <sub>DD</sub>	--	6.5	10	mA	V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>o</sub> =0mA
关断电流	I <sub>SD</sub>	--	0.6	2	μA	V <sub>PIN1</sub> =V <sub>DD</sub>
输出偏压	V <sub>OS</sub>	--	5.0	50	mV	V <sub>IN</sub> =0V
输出功率	P <sub>O</sub>	--	1.2	--	W	THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω
		--	1.4	--		THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω
总谐波失真+噪音	THD+N	--	0.25	--	%	20Hz≤f≤20KHz, A <sub>VD</sub> =2, R <sub>L</sub> =8Ω, P <sub>O</sub> =1W
电源抑制比		--	60	--	dB	V <sub>DD</sub> =4.9V~5.1V

八、电路原理图



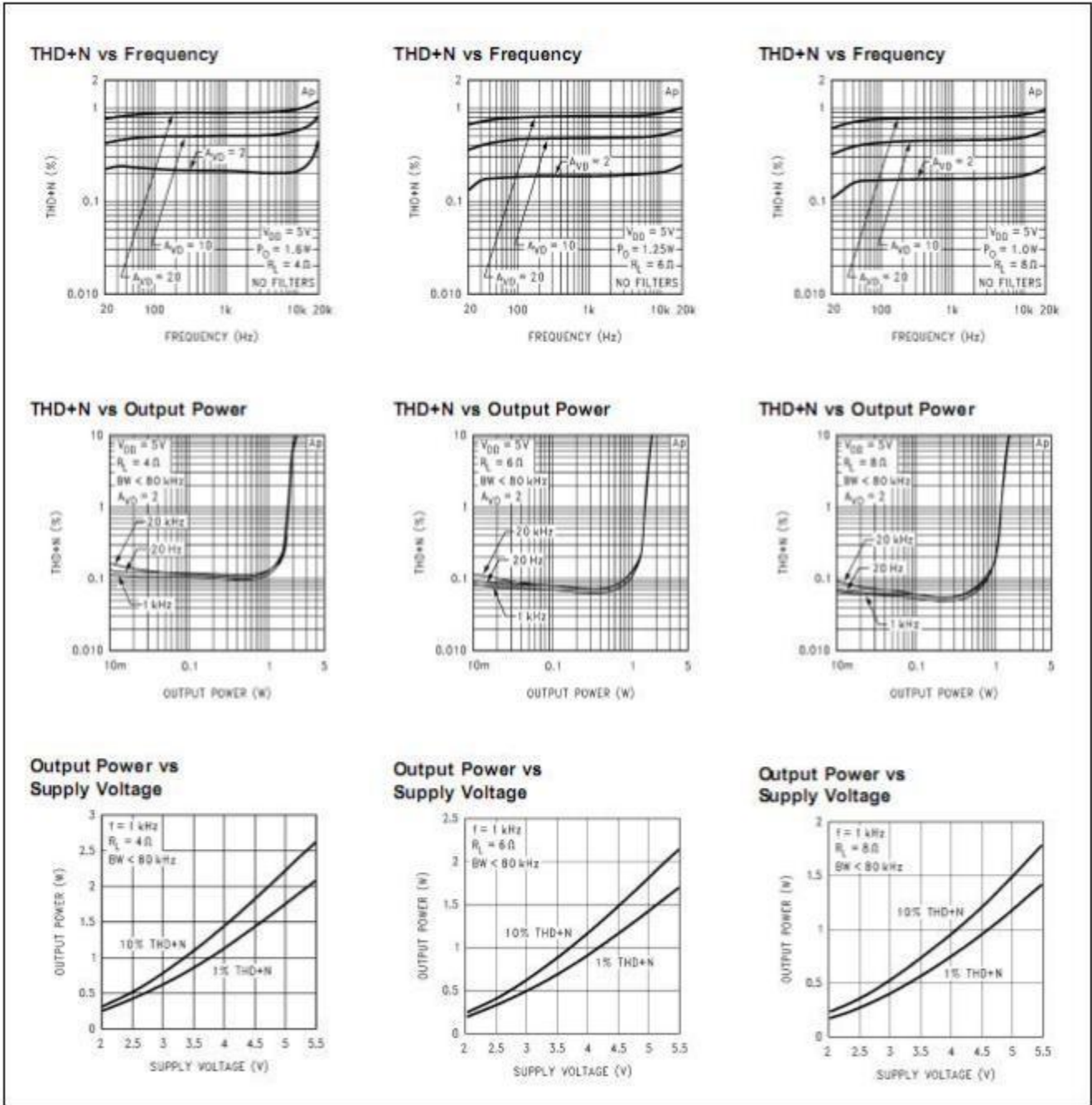


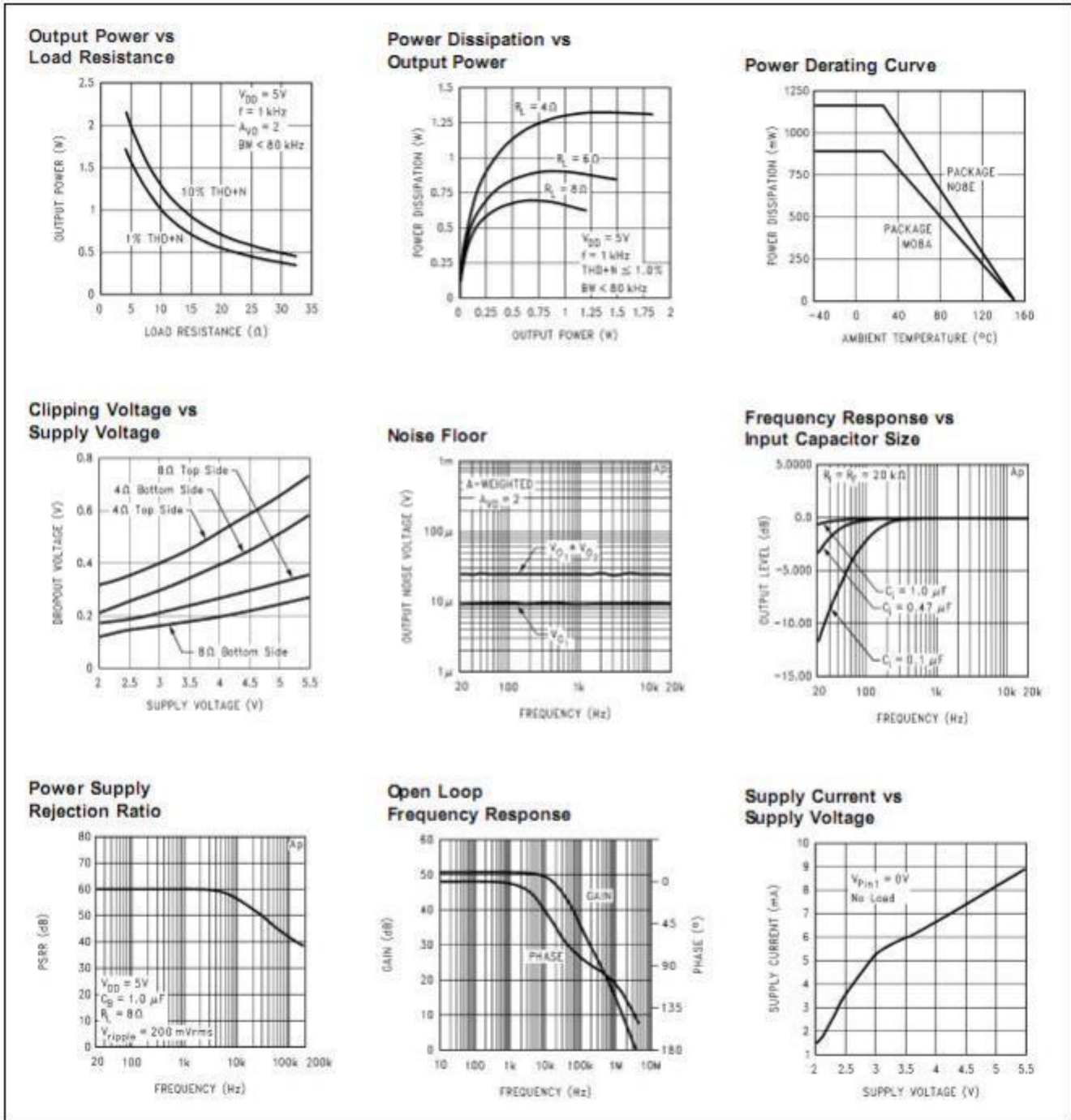
[www.superchip.cn](http://www.superchip.cn)

第 3 页 共 6 页

Version 1.1

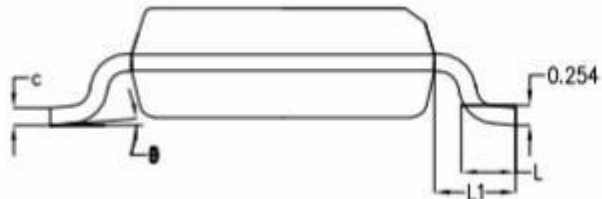
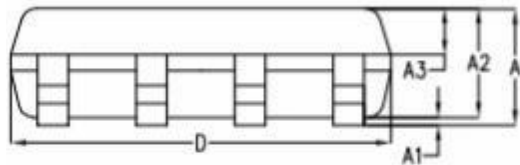
九、特性参数





十、封装尺寸图

➤ SOP-8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
$\theta$	0°	4°	6°